26 p-n-Переход

p-n- $\Pi e p e x o \partial$ — это место соприкосновения p- и n-полупроводников (рис. 1).

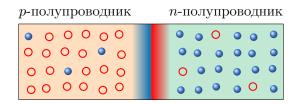


Рис. 1. *p*–*n*-Переход

При образовании контакта между p- и n-полупроводниками свободные электроны (синие шары), совершая тепловое движение, проникают из n-области в p-область, а дырки (красные окружности) — из p-области в n-область (свободные электроны и дырки стремятся «смешаться» друг с другом, подобно тому как стремятся смешаться две жидкости, налитые в один сосуд).

В результате этого в пограничном слое n-полупроводника имеется недостаток электронов — этот слой оказывается заряженным nono исительно (красная область). Пограничный слой же p-полупроводника становится заряженным om-рицательно (синяя область) вследствие ухода из него дырок и прихода в него электронов. Заряженные пограничные слои образуют так называемый sanupa-sou (красно-синяя область): граница p-n-структуры находится как бы в «конденсаторе», внутреннее поле которого (запирающее поле) препятствует дальнейшему переходу свободных электронов и дырок через границу.

Пусть p-n-структура подключена к источнику тока так, что «плюс» источника подан на p-полупроводник, а «минус» — на n-полупроводник (рис. 2).

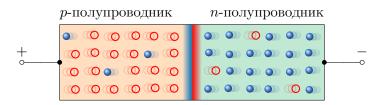


Рис. 2. Прямое включение *p*–*n*-перехода

Внешнее электрическое поле, создаваемое заряженными выводами источника (*+* и *-*) внутри структуры, направлено npomue запирающего поля: на рис. 2 внешнее поле вблизи границы направлено вправо, а запирающее поле — влево. Переходы основных носителей заряда (свободных электронов в n-полупроводнике и дырок в p-полупроводнике) через границу облегчаются: внешнее поле «помогает» свободным электронам и дыркам преодолеть запирающий слой (они массово перемещаются через границу контакта: свободные электроны устремляются к «плюсу» источника, а дырки — к его «минусу»). В этом случае сопротивление p-n-перехода мало́, и mok через nepexod okasывается fontuma (источник практически замкнут nakopomko).

Показанный на рис. 2 способ подключения p-n-перехода к источнику называется npямым включением p-n-перехода. При обратном включении p-n-переход подключается наоборот: p-область соединяется с «минусом» источника, n-область — с «плюсом» (в таком случае m ок через n ереход n ренебрежимо мал).